

TiC/Ti₃AlC₂ 复合材料的原位合成

刘波波¹ 王芬¹ 朱建锋^{1,2} 张芳² 李亚玲²

(1 陕西科技大学材料科学与工程学院, 西安 710021)

(2 西安交通大学, 西安 710049)

文 摘 以 Ti 粉、铝粉和活性碳粉为反应原料, 利用高能球磨及热压工艺合成了 TiC/Ti₃AlC₂ 复合材料。研究了在 Ti - Al - C 体系中, 温度对 TiC/Ti₃AlC₂ 复合材料的影响, 并重点分析了反应过程热力学机理及材料微观结构的影响。结果表明: 通过高能球磨及热压烧结, 在 1 300℃ 时得到了物相比较均匀、致密的 TiC/Ti₃AlC₂ 复合材料。通过高能球磨使得晶粒不断得到细化, 使 Ti₃AlC₂ 的烧结温度降低, 同时分析 TiC/Ti₃AlC₂ 复合材料微观结构的增韧机理, 发现 TiC 是以颗粒增韧方式镶嵌在 Ti₃AlC₂ 基体中。

关键词 TiC/Ti₃AlC₂, 复合材料, 高能球磨, 热压烧结

Synthesis of Machinable Ternary TiC/Ti₃AlC₂ Composites by In-Situ Reactions

Liu Bobo¹ Wang Fen¹ Zhu Jianfeng^{1,2} Zhang Fang² Li Yaling²

(1 School of Materials Science and Engineering, Shaanxi University of Science and Technology, Xi'an 710021)

(2 Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049)

Abstract The micro-structural ternary layered single phase TiC/Ti₃AlC₂ composite was synthesized by high energy milling and hot-pressing with Ti, Al and reactive C powders as raw materials. The in-situ reactive processes and the effects of microstructure was examined by DSC, XRD and SEM. The results show that uniform and dense TiC/Ti₃AlC₂ composites ceramics are successfully obtained by hot-pressing and high-energy milling of the powders at 1 300℃. High-energy milling made the grain become fine continuously and the synthesis temperature for Ti₃AlC₂ decreased. At the same time, by analyzing the toughening mechanism of the micro-structure of the composite, it is found that TiC is embedded in Ti₃AlC₂ matrix by the way of particles toughening.

Key words TiC/Ti₃AlC₂, Composites, High-energy milling, Hot pressing

1 引言

TiC 是一类具有优良力学性能和高温性能的新材料, 具有密度低、高温强度高, 抗蠕变和抗氧化能力强等优点, 但金属间化合物^[1~2]塑性差, 硬脆难以加工成型。Ti₃AlC₂ 陶瓷^[3] 具有很好的高温强度、热稳定性和耐腐蚀性能, 同时它还具有高的弹性模量、硬度和耐磨等优点。TiC/Ti₃AlC₂ 复合材料^[4~6] 综合两者的优点, 克服缺点, 大大提高了材料的可加工性能。

在较快的加热速度下, 梅炳初等^[7] 用 3Ti1Al2C 混合粉通过放电等离子烧结合成了含有少量 TiC 的 Ti₃AlC₂ 复合材料。该技术反应时间短, 一般在 1 min

内完成, 反应温度波动比较大, 反应温度高、产物晶粒细小、活性大。然而, 由于热压时间短, 其合成产物多为疏松的开裂状, 存在大量的孔洞。但反应温度太高, 反应过程短不好控制。

本文以 Ti/Al 以及活性炭为原料, 利用高能球磨^[8~9] 及热压工艺合成了 TiC/Ti₃AlC₂ 复合材料。通过 DSC、XRD、SEM 等测试手段对合成过程进行研究。

2 实验

采用原料 Ti 粉(纯度 99.3%, 280 目)、Al 粉(纯度 99.5%, 200 目)、活性炭(纯度 99.0%, 粒径 4.47 μm), 分别称取 71.11 g Ti 粉、20.00 g Al 粉和 20.00 g 活性炭为原料, 分别加入 2% 分散剂, 球料比为 18:

收稿日期: 2008-08-27; 修回日期: 2008-10-09

作者简介: 刘波波, 1984 年出生, 硕士研究生, 主要从事金属间化合物及其复合材料的研究。E-mail: yupiner2003@163.com

1 进行高能球磨,球磨时间为 12 h,球磨转速为 1 000 r/min。球磨后将粉料经真空干燥处理后装入石墨模型内,抽真空到 5.3×10^{-2} Pa 后,以 5°C/min 的升温速率加热到不同温度,并调节压力至 30 MPa,在该温度点保温保压 60 min,而后随炉自然冷却。采用 CRY-ZP 型差热分析仪对预制混合粉进行差热分析,升温速率为 10°C/min。采用日本理学 D/max-2200PC X 射线衍射仪^[10]和 JSM-6700 扫描电镜进行物相分析。

3 结果与讨论

3.1 XRD 分析

图 1 为不同烧结温度的 XRD 衍射图谱,可以看出试样随烧结温度不同主要成分为 Ti_3AlC_2 和 TiC,也有少量的杂质 Al_3Ti 。随着反应温度升高,产物的衍射峰明显增加,而且杂质相逐渐消失。当烧结温度为 1 200°C 时,发现有一定量的 Ti_3AlC_2 和 TiC,而且有少量 Al_3Ti 的衍射峰,反应刚开始时 Ti_3AlC_2 和 TiC 的衍射峰不是很强。随着温度继续升高,在 1 250°C 时 Ti_3AlC_2 和 TiC 的衍射峰明显增强,其中 TiC 的衍射峰高于 Ti_3AlC_2 ,杂质相 Al_3Ti 也消失,说明这一过程中 Al_3Ti 向 TiC 转化。在 1 300°C 时,反应生成的 Ti_3AlC_2 和 TiC 含量继续增加,其中 Ti_2AlC 的衍射峰高于 TiC。当烧结温度升高到 1 350°C 时,主要成分是 Ti_3AlC_2 和 TiC,但此时 TiC 衍射峰明显高于 Ti_3AlC_2 ,考虑到 Al 的挥发对生成产物的影响,在 1 200°C、1 250°C 时 Ti_3AlC_2 和 TiC 的衍射峰增加,在 1 300°C 时 Ti_3AlC_2 的衍射峰最高,温度升高到 1 350°C 时,可能 Ti_3AlC_2 分解生成 TiC 和 Al,由于此时 Al 挥发,所以 TiC 的衍射峰明显增强,高于 Ti_3AlC_2 ,通过以上说明 1 300°C 是生成 $\text{TiC}/\text{Ti}_3\text{AlC}_2$ 复合材料的最合适温度。

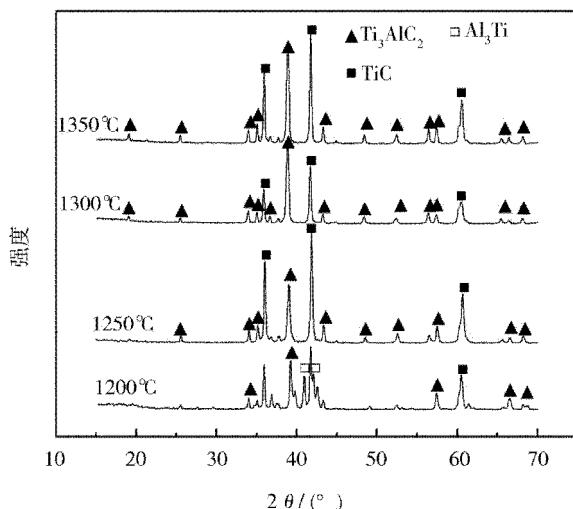


图 1 试样在不同烧结温度的 XRD 衍射图

Fig. 1 XRD patterns of samples at defferent sintering temprature

3.2 DSC 分析

Ti-Al-C 系统机械合金化粉体的热分析结果见图 2。

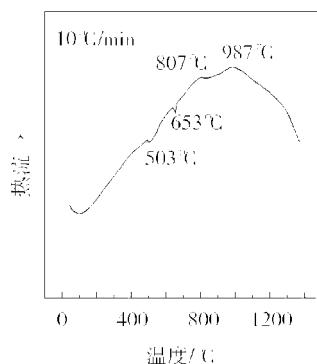


图 2 粉样的 DSC 曲线

Fig. 2 DSC curve of powders

图 2 的 DSC 曲线上呈现四个峰值,两个吸热峰和两个放热峰。两个吸热峰对应温度为 503、653°C;两个放热峰对应温度为 807、987°C。结合文献[11]可以看出:503°C 的吸热峰显示 Ti-Al-C 体系开始发生化学反应。653°C 附近的吸热峰对应着 Al 的熔化温度,表明在热压烧结过程中首先发生的反应为 Al 的熔化。807°C 附近的第一和 987°C 的第二个放热峰都为 Ti 和 Al 之间的反应,表明在 Al-Ti-C 预制块中发生了反应——Al、Ti 间的放热反应。807°C 发生反应: $\text{Ti} + 3\text{Al} \rightarrow \text{Al}_3\text{Ti}$ 。987°C 附近的放热峰表明 Al-Ti-C 预制块中发生了另一个反应: $\text{Al}_3\text{Ti} + 2\text{Ti} \rightarrow 3\text{TiAl}$ 。通过高能球磨,经研磨体的猛烈撞击和摩擦作用,发生反复塑变、冷焊、加工硬化和破碎等过程,使得晶粒不断得到细化。在冷焊的作用下,形成了聚合力很强的纳米晶聚集体。晶粒的细化可使得元素的扩散能力大幅度提高,这主要是通过高能球磨形成的纳米晶粒产生了大量的界面,增加了短路扩散路径所占的比例,提高了材料的扩散能力。同时经高能球磨形成了聚合力很强的复合团粒,极大地降低了界面反应阻力,使得 Al、Ti 和 C 原子的扩散能力得到了提高。

图 3 是试样在不同烧结温度时断口 SEM 图,结合 XRD 衍图可知主要物质都是 $\text{TiC}/\text{Ti}_3\text{AlC}_2$ 复合材料。图 3(a) 中黑的部分是 Ti_3AlC_2 相,小白点是 TiC 晶粒,此时 Ti_3AlC_2 和 TiC 晶粒排布比较均匀,但试样的致密度不是很高,晶粒发育不是很好,晶粒尺寸较小。另外由于晶粒尺寸小杂质相 Al_3Ti 看起来不是很明显,只能通过 XRD 衍射图谱区分物相。图 3(b) 中物质主要是 Ti_3AlC_2 和 TiC,此时晶粒发育良好,有明显的层状结构,可以看见 TiC 颗粒均匀地镶嵌在

Ti_3AlC_2 层状基体中,而且分布比较均匀。图 3(c) 中的层状结构主要是 Ti_3AlC_2 , TiC 主要分布在 Ti_3AlC_2 的晶界上,虽然含量较多但分布极不均匀。通过以上

分析说明 1 300℃时,合成的 TiC/Ti_3AlC_2 复合材料比较均匀,从镶嵌方式上可以看出这时的 TiC/Ti_3AlC_2 复合材料比较致密。

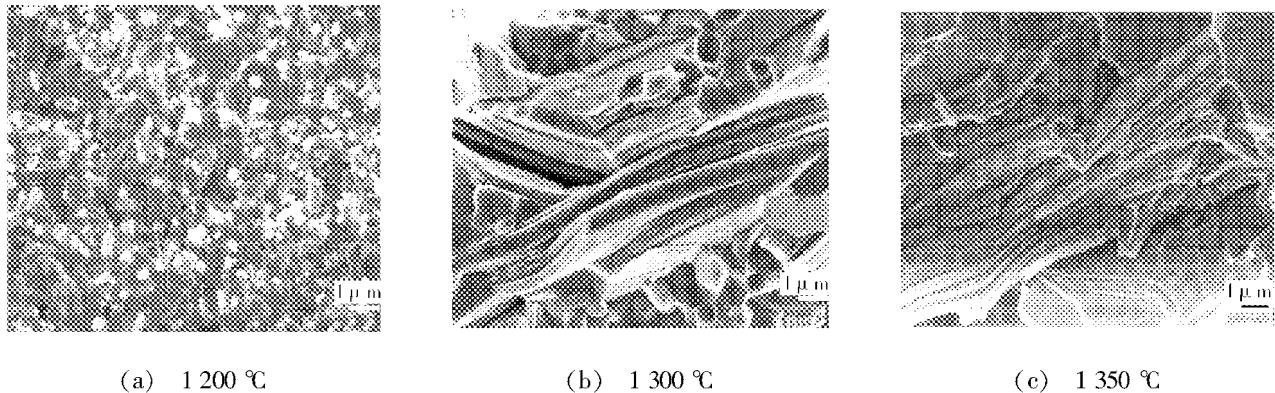


图 3 不同温度烧结样品的断口 SEM 照片

Fig. 3 Scanning electron microscope photographs at different sintering temperature

从图 3(b)中可看到晶粒长大为长片型,其中仍有少量 TiC 存在。从扫描电镜的分析,可以知道该反应最终产物生成阶段是介于液相临界的固相反应。对于 $Ti - Al - C$ 、合成 Ti_3AlC_2 体系,根据自由能计算公式: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$,由于 $-T\Delta S > 0$, $\Delta H < 0$ (T 温度, ΔS 熵变, ΔH 焓变),所以当温度较低时,不会改变反应的 ΔG 符号,但温度很高时就可能改变 ΔG 的符号。因此当燃烧反应温度很高, Ti_3AlC_2 的 ΔG 由负值变为零时, TiC 的生成自由能仍为负值($\Delta G < 0$)。可见温度升高时, Ti_3AlC_2 的 ΔG 的绝对值减小,从热力学上考虑,生成 TiC 的温度上限比生成 Ti_3AlC_2 的温度上限宽。所以反应到一定阶段出现了 Ti_3AlC_2 的分解。

4 结论

(1) 通过高能球磨及热压烧结在 1 300℃时得到了物相比较均匀的、致密的 TiC/Ti_3AlC_2 复合材料。

(2) 通过高能球磨使得晶粒不断得到细化,使 Ti_3AlC_2 的烧结温度降低,同时分析 TiC/Ti_3AlC_2 复合材料微观结构的增韧机理, TiC 以颗粒增韧方式镶嵌在 Ti_2AlC 基体中。

参考文献

1 张永刚等主编. 金属间化合物结构材料. 第 1 版. 北京: 国防工业出版社, 2001

2 赵树萍, 吕双坤, 赫文杰. 钛合金及其表面处理. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2003: 84~85

3 Myhra S, Crossl Ey J A, Barsoum M W. Crystal chemistry of the Ti_3AlC_2 and Ti_4AlN_3 layered carbide/nitride phases characterization by XPS. *J Phys. Chem. Solids*, 2001; 62(4): 811~817

4 吕维洁, 张小农, 张荻等. 原位合成 TiB/Ti 基复合材料增强相的生长机制. *金属学报*, 2000; 36(1): 104~108

5 罗国珍. 钛基复合材料的研究与发展. 稀有金属材料与工程, 1997; 26(2): 1~7

6 金松哲, 梁宝岩, 孙世成. 机械合金化 + 烧结制备 TiC/Ti_3SiC_2 复合材料. *材料热处理*, 2007; 36(4): 30~34

7 梅炳初, 徐学文, 朱教群, 刘俊. Ti_3AlC_2 的制备与微观结构. *硅酸盐学报*, 2004; 32(7): 897~900

8 马乃恒, 方小汉, 梁工英等. 高能球磨对 $Al - Ti - C$ 粉料混合物粒度和组织的影响. *复合材料学报*, 2002; 19(2): 33~36

9 贺文雅, 李小强, 胡连喜等. 机械球磨对 Ti, Al 复合粉扩散反应的影响. *材料科学与工艺*, 2000; 8(4): 26

10 王英华. X 射线衍射技术基础. 北京: 原子能出版社, 1993

11 王素梅, 孙康宁, 卢志华等. $Ti - Al/TiC$ 陶瓷基复合材料烧结过程的研究. *Journal of Materials Science & Engineering*, 2003; 21(4): 565~569

(编辑 李洪泉)